МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника Лабораторный практикум №4

Работу выполнил:

студент группы ИУ7-33Б

Паламарчук А. Н.

Работу проверил:

Оглоблин Д.И.

ДИОД: KD202D

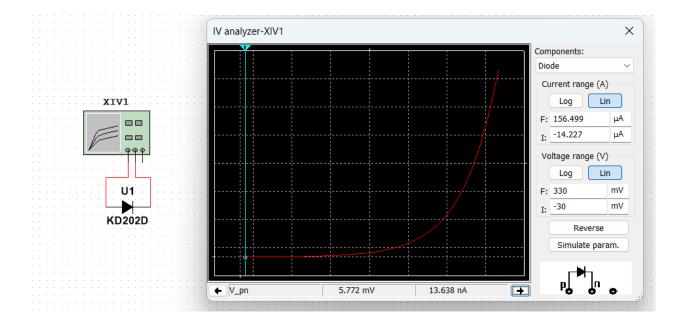
Цель работы:

Получение и исследование статических и динамических характеристик германиевого и кремниевого полупроводниковых диодов с целью определение по ним параметров модели полупроводниковых диодов, размещения моделей в базе данных программ схемотехнического анализа. Приобрести навыки в использовании базовых возможностей программ схемотехнического анализа, на примере программы Multisim, для исследования статических и динамических характеристик полупроводниковых диодов с последующим расчетом параметров модели полупроводникового диода. Приобретение навыков расчета моделей полупроводниковых приборов по данным, полученным в экспериментальных исследованиях и включение модели в базу компонентов.

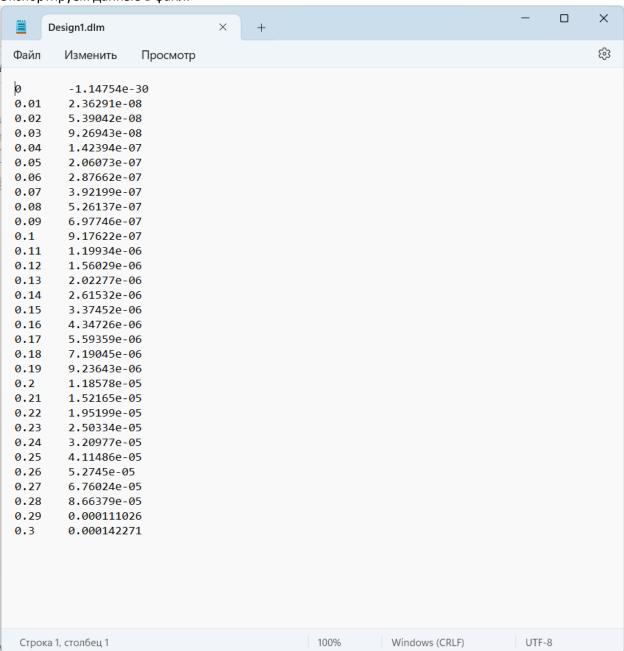
Эксперимент 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА IV ANALYZER.

Цель эксперимента: Получить BAX диода KD202D в программе Multisim с применением виртуального прибора IV analyzer, используемого для снятия BAX р-ппереходов, диодов, транзисторов.

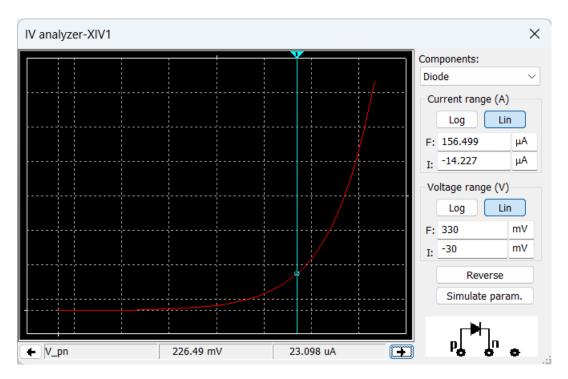


Экспортируем данные в файл.



Исследуем ВАХ в диапазоне температур от -30 до 70 градусов Цельсия:

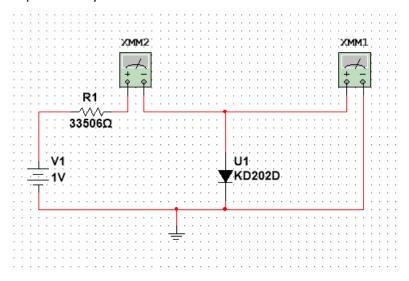
- 1) Для начала рассчитаем R1, которое обеспечит работу диода
- а) Выберем произвольно рабочую точку диода на графике BAX, снятом IV analyzer:



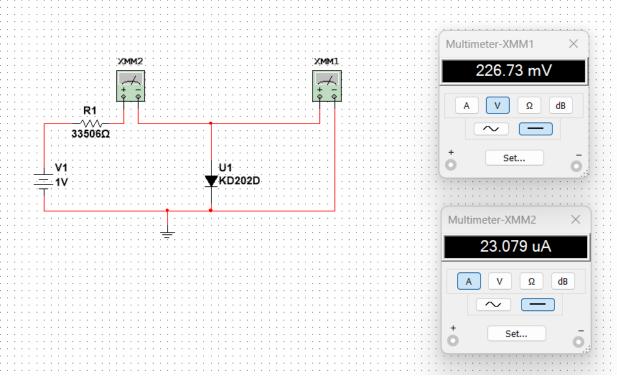
b) Рассчитаем сопротивление при источнике 1B:

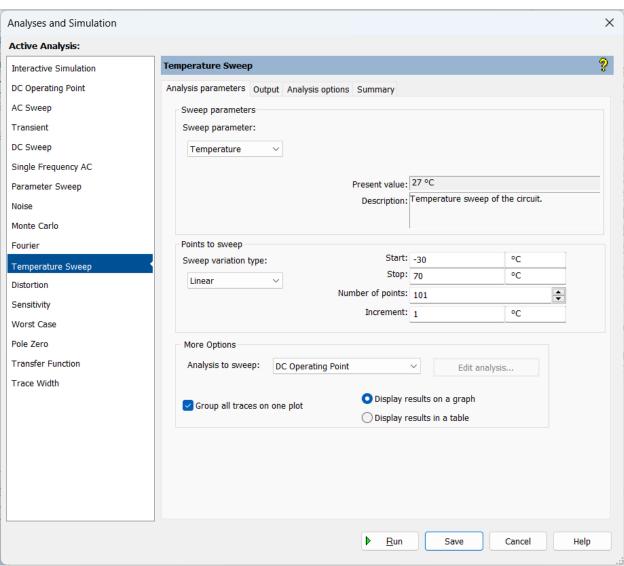
$$R = (Uuct - Ud)/Id = (1-0.226)/(23.1 * 10^(-6)) = 33506 Om$$

Строим схему:

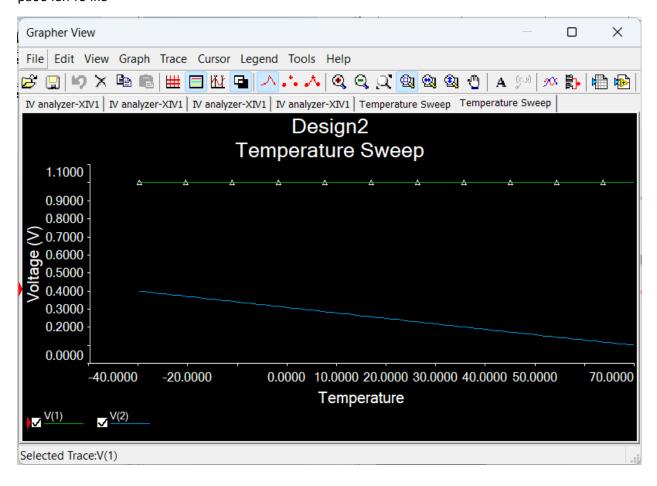


Проверка выбранной рабочей точки:

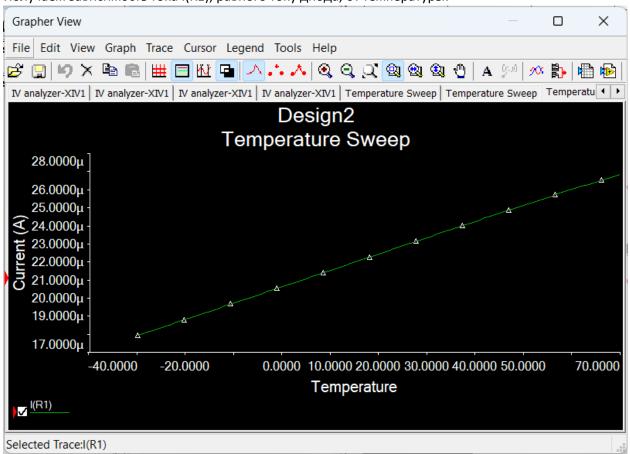




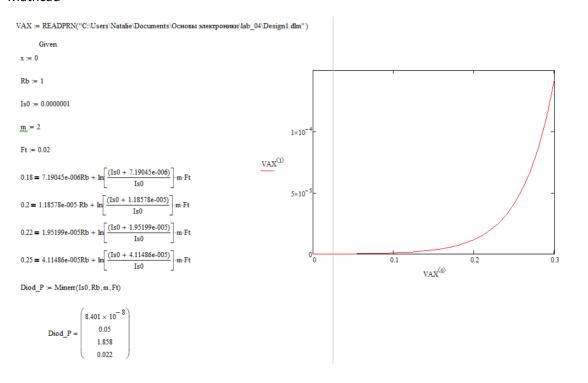
Получаем зависимость V1, V2 — напряжения на источнике и диоде от температуры в выбранной рабочей точке



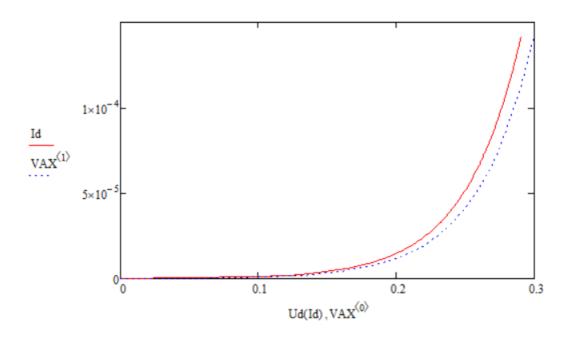
Получаем зависимость тока I(R1), равного току диода, от температуры.



Mathcad



$$\begin{split} \text{Id} &:= 0, 10^{-6} ... 1.423 \times 10^{-4} & \text{max} \Big(\text{VAX}^{\left< 0 \right>} \Big) = 0.3 \\ \text{Ud}(\text{Id}) &:= \text{Id} \cdot \text{Rb} + \text{m} \cdot \text{Ft} \cdot \text{In} \Bigg[\frac{(\text{Id} + \text{Is0})}{\text{Is0}} \Bigg] & \text{max} \Big(\text{VAX}^{\left< 1 \right>} \Big) = 1.423 \times 10^{-4} \end{split}$$

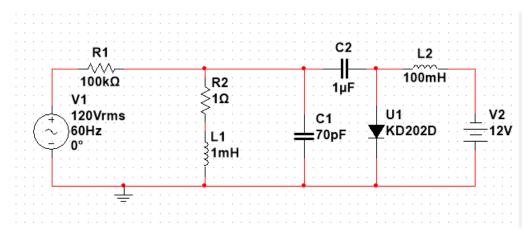


Эксперимент 6

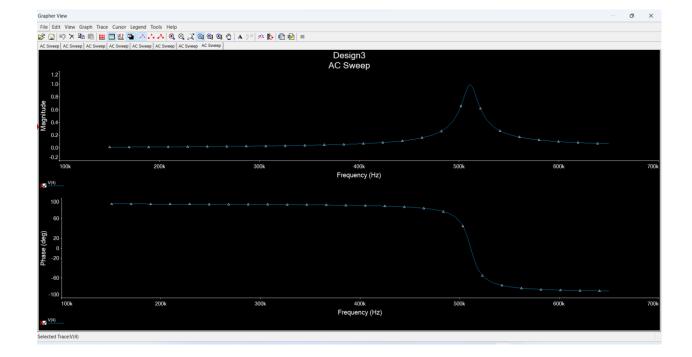
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТФАРАДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА.

Цель эксперимента: Используя схему параллельного колебательного контура с подключенным к контуру полупроводниковым диодом в качестве переменной емкости, построить зависимость резонансной частоты от напряжения управления и передать данные в программу MathCAD. По этим данным построить вольтфарадную характеристику полупроводникового диода

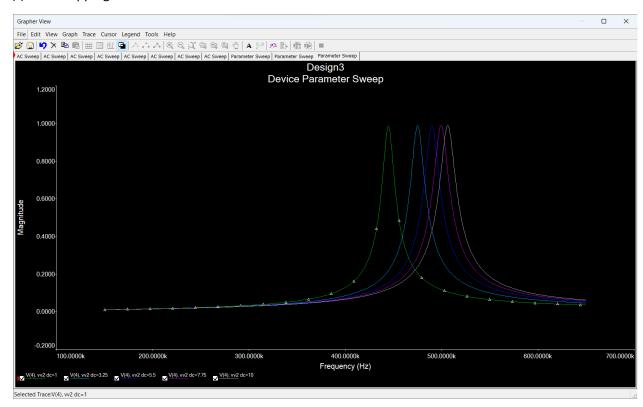
Строим схему:



Получил резонансную частоту:



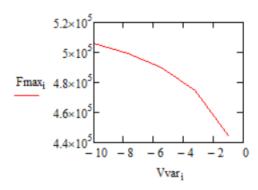
Делаю stepping:



Вручную выписываю пики:

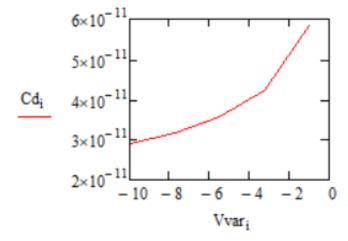
Fmax :=
$$\begin{pmatrix} 444563 \\ 474922 \\ 489868 \\ 499365 \\ 506215 \end{pmatrix}$$
 Vvar :=
$$\begin{pmatrix} -1 \\ -3.25 \\ -5.5 \\ -7.75 \\ -10 \end{pmatrix}$$

i := 0..4



$$Lk := 10^{-3}$$
 $Ck := 70 \cdot 10^{-12}$ $pi := 3.14$ $Fr_i := Fmax_i$

$$Cd := \frac{-\left(Ck \cdot Lk - \frac{1}{4 \cdot Fr^2 \cdot pi^2}\right)}{Lk}$$



$$M := 0.25$$

$$VJ0 := 0.75$$

$$M := 0.25$$
 $VJ0 := 0.75$ $CJ0 := 3 \cdot 10^{-12}$

Given

$$1.241807295376e-011 = CJ0 \cdot \left(1 - \frac{-3.25}{VJ0}\right)^{-M}$$

$$5.6629109872239e-012 = CJ0 \cdot \left(1 - \frac{-5.5}{VJ0}\right)^{-M}$$

$$1.6821013942309e-012 = CJ0 \cdot \left(1 - \frac{-7.75}{VJ0}\right)^{-M}$$

Minerr(CJ0, VJ0, M) =
$$\begin{pmatrix} 4.4 \times 10^{-11} \\ 3.384 \times 10^{4} \\ 1.31 \times 10^{4} \end{pmatrix}$$

$$U := -10, -8..0$$

CJexp :=
$$4.4 \cdot 10^{-11}$$
 VJexp := $3.384 \cdot 10^4$ Mexp := $1.31 \cdot 10^4$

$$VIexp = 3.384 \cdot 10^4$$

Mexp :=
$$1.31 \cdot 10^4$$

$$Cdexp(U) := CJexp \cdot \left(1 - \frac{U}{VJexp}\right)^{-Mexp}$$

$$CJdiod := 82 \cdot 10^{-12}$$

$$VJdiod := 0.75$$

Mdiod := 0.38

$$Cddiod(U) := CJdiod \left(1 - \frac{U}{VJdiod}\right)^{-Mdiod}$$

